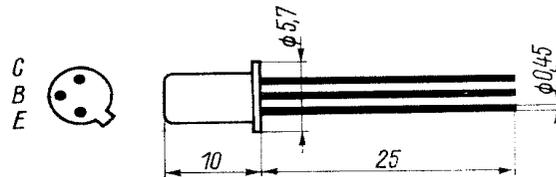


Germanium-pnp-Transistor der Bauform A 3/25-b nach TGL 11 811 für Steuer- und Regelzwecke mit induktiver Last und hoher Sperrspannung, besonders in Ablenkeinheiten von TV-Empfängern.



Masse ca. 0,8 g

Wärmewiderstand	R_{thja}	$\leq 0,38$ grad/mW
Wärmewiderstand	R_{thjc}	$\leq 0,05$ grad/mW

Grenzwerte; gültig für den Betriebstemperaturbereich

Kollektor-Emitter-Spannung	$-U_{CES}$	$= 80$ V
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{EBO}$	$= 20$ V
Kollektorstrom	$-I_C$	≤ 150 mA
Basisstrom	$-I_B$	≤ 50 mA
Sperrschichttemperatur	ϑ_j	$= +80$ °C
Betriebstemperaturbereich		-25 °C bis $+65$ °C

Statische Kennwerte

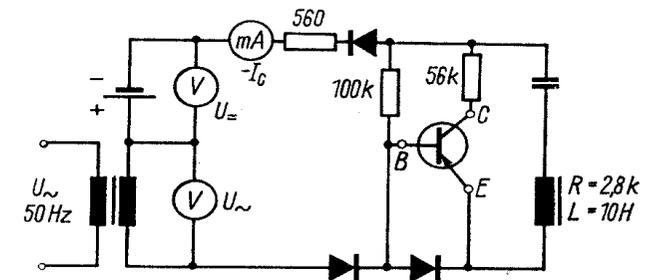
	Min.	Typ	Max.
Kollektor-Basis-Reststrom			$10 \mu A$
$-U_{CB} = 6$ V			
Kollektor-Emitter-Reststrom		$300 \mu A$	$500 \mu A$
$-U_{CES} = 80$ V			
Emitter-Basis-Reststrom			$50 \mu A$
$-U_{EB} = 10$ V			

Dynamische Kennwerte

Übergangsfrequenz	f_T	300 kHz	
$-U_{CE} = 6$ V			
$-I_C = 2$ mA			
Kurzschlußstromverstärkung	h_{21e}	10	80
$-U_{CE} = 6$ V			
$-I_C = 2$ mA			
$f = 1$ kHz			

Spezialmessung:

Kollektorstrom nach angegebener Schaltung: $-I_C = 10$ mA
 $-U_{CE} = U_+ + U_-$
 $U_+ = (66 \text{ V} \pm 2) \text{ V}$
 $U_- = (90 \text{ V} \pm 5) \text{ V}_{eff}$



Bestellbeispiel für einen Transistor

Transistor GC 112